

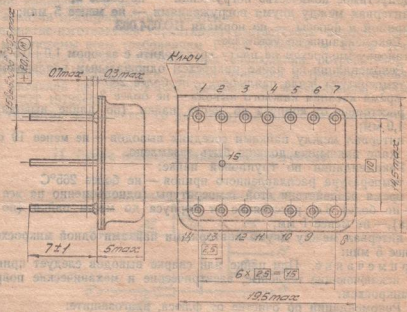


Микросхема
K228УВ1 (K2УС281)

ПАСПОРТ

МИКРОСХЕМА ТИПА K228УВ1 СООТВЕТСТВУЕТ
ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 6КО.348.001 ТУ.

1. Функциональное назначение — усилитель универсальный.
2. Габаритный чертеж микросхемы.



3. Режим работы:

- а) напряжение питания: $E_k = 6,3 \text{ В} \pm 10\%$; $E_{см} = \text{минус } 6,3 \text{ В} \pm 10\%$;
 - б) мощность, потребляемая от источника питания, не более 70 мВт.
4. Основные электрические параметры:
- номинальное значение крутины вольтамперной характеристики на частоте 5 МГц $10 \pm 1 \text{ мА/В}$
 - номинальное значение крутины вольтамперной характеристики на частоте 60 МГц $\geq 7,5 \text{ мА/В}$
 - входное сопротивление на частоте 60 МГц $\geq 200 \text{ Ом}$
 - выходное сопротивление на частоте 60 МГц $\geq 10 \text{ кОм}$
 - ток коллектора $2,9 - 4,3 \text{ мА}$
 - максимальная рабочая частота 60 МГц

5. Содержание драгоценных металлов в одной микросхеме: «Золото — 39,595 мг».

6. Указания и рекомендации по установке, монтажу и эксплуатации. Режимы и условия монтажа микросхем в аппаратуре.

а) Рекомендации по лужению методом погружения в расплавленный припой:

- температура расплавленного припоя — не более 250°C;
- время погружения — не более 2 с;
- расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм;
- допустимое количество погружений — не более 2;
- интервал между двумя погружениями — не менее 5 мин;
- припой и флюсы — по нормам ГО.054.063.

б) Рекомендации по установке.

Установку микросхем на плату производить с зазором 1,0±0,5 мм.

- в) Рекомендации по пайке микросхем одножальным паяльником:
- температура жала паяльника — не более 280°C;
 - время касания каждого вывода — не более 3 с;
 - расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) — не менее 1,0 мм;
 - интервал между пайками соседних выводов — не менее 10 с.
- г) Рекомендации по групповой пайке:
- температура расплавленного припоя — не более 265°C
 - время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) — не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), — не менее 1 мм;
 - интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы — не менее 5 мин;

Примечание. При пайке или сварке выводов следует принимать меры, исключающие тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

д) Рекомендации по очистке от флюса, влагозащите:

- рекомендуется применять для очистки от флюса жидкости в соответствии с нормами ГО.054.063;
- рекомендуется для влагозащиты применять лак УР-231 или Э-4100 (МРТУ 6-10-863-69, МРТУ 6-10-857-69).

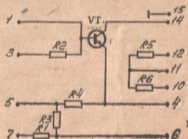
Примечание. Для очистки от флюса и влагозащиты микросхем допускается применять любые другие моющие жидкости, лаки, не оказывающие вредного химического воздействия на покрытие, маркировку и материалы корпусов после согласования со специализированной организацией по приению интегральных микросхем и проведения соответствующих испытаний.

7. Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от минус 45 до +70°C;
 - относительная влажность воздуха при температуре $T = +25^{\circ}\text{C}$ 98% влажности;
 - вибрация с ускорением до 10 g в диапазоне частот от 1 до 600 Гц;
 - многократные удары с ускорением до 75g;
 - линейные (центробежные) нагрузки с ускорением до 25g;
8. Время наработки — 10000 часов.
9. Срок хранения — 6 лет.
10. Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждой поставленной микросхемы всем требованиям ГОСТ 18725-73 и ТУ в течение срока сохраняемости или наработки при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации, установленных ГОСТ 18725-73.

Срок гарантии исчисляется со дня отгрузки микросхем потребителю.

11. Схема принципиальная электрическая.



$R1 = 1,2 \text{ кОм} \pm 10\%$; $R2 = 6,2 \text{ кОм} \pm 20\%$; $R3 = 10^4 \text{ Ом} \pm 5\%$;
 $R4 = 84 \text{ Ом} \pm 5\%$; $R5 = 470 \text{ Ом} \pm 10\%$; $R6 = 200 \text{ Ом} \pm 10\%$.
 VT — транзистор 2Т318В.

12. Масса микросхемы не более 3 г.
13. Дата выпуска.

ШТАМП ОТК.



11-79

197 г.